

NPN POWER SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/454

Devices

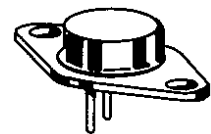
2N5660 2N5661 2N5662 2N5663

Qualified Level

JAN, JANTX
JANTXV

MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N5660 2N5662	2N5661 2N5663	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	200	300	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	250	400	Vdc
Collector-Emitter Voltage	V_{CER}	250	400	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6.0		Vdc
Base Current	I_B	0.5		Adc
Collector Current	I_C	2.0		Adc
		2N5660 2N5661	2N5662 2N5663	
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^{\circ}C$ @ $T_C = +100^{\circ}C$	P_T	2.0 ⁽¹⁾	1.0 ⁽²⁾	W
		20 ⁽³⁾	15 ⁽⁴⁾	W
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-65 to +200		$^{\circ}C$



TO-66*
(TO-213AA)
2N5660, 2N5661



TO-5*
2N5662, 2N5663

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	2N5660 2N5661	2N5662 2N5663	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	5.0	6.67	$^{\circ}C/W$
Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$	87.5	145.8	

- 1) Derate linearly 11.4 mW/ $^{\circ}C$ for $T_A > +25^{\circ}C$
- 2) Derate linearly 5.7 mW/ $^{\circ}C$ for $T_A > +25^{\circ}C$
- 3) Derate linearly 200 mW/ $^{\circ}C$ for $T_C > +100^{\circ}C$
- 4) Derate linearly 150 mW/ $^{\circ}C$ for $T_C > +100^{\circ}C$

*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25^{\circ}C$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 10$ mAdc	2N5660, 2N5662 2N5661, 2N5663	$V_{(BR)CEO}$	200 300	Vdc
Collector-Base Breakdown Voltage $I_C = 10$ mAdc, $R_{BE} = 100\Omega$	2N5660, 2N5662 2N5661, 2N5663	$V_{(BR)CER}$	250 400	Vdc
Emitter-Base Breakdown Voltage $I_E = 10$ μ Adc		$V_{(BR)EBO}$	6.0	Vdc

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
Collector-Emitter Cutoff Current V _{CE} = 200 Vdc V _{CE} = 300 Vdc	I _{CES}		0.2	μAdc
2N5660, 2N5662 2N5661, 2N5663			0.2	μAdc
Collector-Base Cutoff Current V _{CB} = 200 Vdc V _{CB} = 250 Vdc V _{CB} = 300 Vdc V _{CB} = 400 Vdc	I _{CBO}		0.1	μAdc
2N5660, 2N5662			1.0	mAdc
2N5660, 2N5662			0.1	μAdc
2N5661, 2N5663 2N5661, 2N5663			1.0	mAdc

ON CHARACTERISTICS ⁽⁵⁾

Forward-Current Transfer Ratio I _C = 50 mAdc, V _{CE} = 2.0 Vdc	h _{FE}		40	
2N5660, 2N5662			25	
2N5661, 2N5663			40	120
I _C = 0.5 Adc, V _{CE} = 5.0 Vdc			25	75
I _C = 1.0 Adc, V _{CE} = 5.0 Vdc			15	
I _C = 2.0 Adc, V _{CE} = 5.0 Vdc			5.0	
Collector-Emitter Saturation Voltage I _C = 1.0 Adc, I _B = 0.1 Adc I _C = 2.0 Adc, I _B = 0.4 Adc	V _{CE(sat)}		0.4	Vdc
			0.8	
Base-Emitter Saturation Voltage I _C = 1.0 Adc, I _B = 0.1 Adc I _C = 2.0 Adc, I _B = 0.4 Adc	V _{BE(sat)}		1.2	Vdc
			1.5	

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Magnitude of Common Emitter Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio I _C = 0.1 Adc, V _{CE} = 5.0 Vdc, f = 10 MHz	h _{fe}	2.0	7.0	
Output Capacitance V _{CB} = 10 Vdc, I _E = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	C _{obo}		45	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Turn-On Time V _{CC} = 100 Vdc; I _C = 0.5 Adc; I _{B1} = 15 Adc	t _{on}		0.25	μs
2N5660, 2N5662 V _{CC} = 100 Vdc; I _C = 0.5 Adc; I _{B1} = 25 Adc			0.25	
2N5661, 2N5663				
Turn-Off Time V _{CC} = 100 Vdc; I _C = 0.5 Adc; I _{B1} = -I _{B2} = 15 Adc	t _{off}		0.85	μs
2N5660, 2N5662 V _{CC} = 100 Vdc; I _C = 0.5 Adc; I _{B1} = -I _{B2} = 25 Adc			1.2	
2N5661, 2N5663				

SAFE OPERATING AREA

DC Tests				
T _C = +100°C, 1 Cycle, t ≥ 1.0 s				
Test 1				
V _{CE} = 10 Vdc, I _C = 2.0 Adc	2N5660, 2N5661			
V _{CE} = 7.5 Vdc, I _C = 2.0 Adc	2N5662, 2N5663			
Test 2				
V _{CE} = 40 Vdc, I _C = 500 mAdc	2N5660, 2N5661			
V _{CE} = 25 Vdc, I _C = 600 mAdc	2N5662, 2N5663			
Test 3				
V _{CE} = 200 Vdc, I _C = 36 mAdc	2N5660			
V _{CE} = 200 Vdc, I _C = 27 mAdc	2N5662			
Test 4				
V _{CE} = 300 Vdc, I _C = 19 mAdc	2N5661			
V _{CE} = 300 Vdc, I _C = 14 mAdc	2N5663			

(5) Pulse Test: Pulse Width = 300μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331